

Физика и техника полупроводников, 2018, том 52, выпуск 6

Электронные свойства полупроводников

Нифтиев Н.Н., Мамедов Ф.М., Гусейнов В.И., Курбанов С.Ш.

Электропроводность монокристаллов FeIn_2Se_4 на переменном токе

535

Скипетров Е.П., Соловьев А.А., Слынько В.Е.

Вклад кластеров железа в магнитные свойства сплавов $\text{Pb}_{1-y}\text{Fe}_y\text{Te}$

538

Поклонский Н.А., Вырко С.А., Дервяго А.Н.

Квазиклассическая модель статической электропроводности сильно легированных вырожденных полупроводников при низких температурах

544

Евстигнеев В.С., Варавин В.С., Чилиясов А.В., Ремесник В.Г., Моисеев А.Н., Степанов Б.С.

Электрофизические свойства нелегированных и легированных мышьяком эпитаксиальных слоев $\text{Hg}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te}$ р-типа проводимости с $x \sim 0.4$, выращенных методом МOCVD

554

Теруков Е.И., Марченко А.В., Серегин П.П., Жуков Н.Н.

Структура мессбауэровских спектров примесных атомов $^{119\text{m}}\text{Sn}$ в халькогенидах свинца в условиях радиоактивного равновесия изотопов $^{119\text{m}}\text{Te}/^{119}\text{Sn}$

560

Спектроскопия, взаимодействие с излучениями

Хазиева А.Ф., Насиров В.И., Асадов Ю.Г., Алыев Ю.И., Джабаров С.Г., Дашдемиров А.О.

$\text{Rb}_{1-x}\text{Cs}_x\text{NO}_3$ ($x=0.025, 0.05, 0.1$) монокристаллы и их исследование методом высокотемпературной рентгенографии

565

Володин В.А., Сачков В.А., Синюков М.П.

Запрещенное резонансное комбинационное рассеяние света в сверхрешетках GaAs/AlAs : эксперимент и расчеты

569

Поверхность, границы раздела, тонкие пленки

Денисов Н.М., Чубенко Е.Б., Бондаренко В.П., Борисенко В.Е.

Оптические свойства многослойных золь-гель пленок оксида цинка

575

Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления

Пащенко А.С., Лунин Л.С., Чеботарев С.Н., Лунина М.Л.

Исследование структурных и люминесцентных свойств гетероструктур InAs/GaAs с легированными Bi потенциальными барьерами

581

Пушкарев С.С., Грехов М.М., Зенченко Н.В.

Анализ особенностей кристаллической структуры НЕМТ-гетероструктур $\text{GaN}/\text{Al}_{0.32}\text{Ga}_{0.68}\text{N}$ по данным рентгеновской дифрактометрии методом Вильямсона-Холла

586

Ханин Ю.Н., Вдовин Е.Е.

Квантовые осцилляции релаксации фотопроводимости в р-і-n-гетеродиодах $\text{GaAs}/\text{InAs}/\text{AlAs}$

591

Бабичев А.В., Курочкин А.С., Колодезный Е.С., Филимонов А.В., Усикова А.А., Неведомский В.Н., Гладышев А.Г., Карачинский Л.Я., Новиков И.И., Егоров А.Ю., Денисов Д.В.

Гетероструктуры одночастотных и двухчастотных квантово-каскадных лазеров

597

Михайлов А.И., Кабанов В.Ф., Горбачев И.А., Глуховской Е.Г.

Исследование свойств квантовых точек полупроводников $\text{A}^{\text{IV}}\text{B}^{\text{VI}}$ и $\text{A}^{\text{III}}\text{B}^{\text{V}}$

603

Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники	
Жуков Н.Д., Роках А.Г., Шишкин М.И.	
Свойства наночастиц сульфида свинца в мультимерной структуре	608
Углеродные системы	
Опенев Л.А., Подливаев А.И.	
Влияние дегидрирования графана на его механические и электронные свойства	614
Кухарь Е.И., Крючков С.В., Ионкина Е.С.	
О возможности распространения уединенной электромагнитной волны в биграфене	620
Физика полупроводниковых приборов	
Лавров С.Д., Шестакова А.П., Мишина Е.Д., Ефименков Ю.Р., Сигов А.С.	
Высококочувствительный фотодетектор на основе атомарно-тонкого MoS₂	625
Майборода И.О., Грищенко Ю.В., Езубченко И.С., Соколов И.С., Черных И.А., Андреев А.А., Занавескин М.Л.	
Туннельный ток во встречных диодах Шоттки, образованных контактами между вырожденным GaN n-типа и металлом	630
Александров О.В., Мокрушина С.А.	
Модель накопления зарядов в n- и р-МОП-транзисторах при туннельной инжекции электронов из затвора	637
Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур	
Малин Т.В., Милахин Д.С., Мансуров В.Г., Галицын Ю.Г., Кожухов А.С., Ратников В.В., Смирнов А.Н., Давыдов В.Ю., Журавлев К.С.	
Влияние степени нитридации сапфира и обогащения алюминием зародышевого слоя на структурные свойства слоев AlN	643
Иванова М.М., Качемцев А.Н., Михайлов А.Н., Филатов Д.О., Горшков А.П., Волкова Н.С., Чалков В.Ю., Шенгуров В.Г.	
Влияние импульсного гамма-нейтронного облучения на фоточувствительность фотодиодов на базе Si с nanoостровками GeSi и эпитаксиальными слоями Ge	651
Кукушкин С.А., Калинин И.П., Осипов А.В.	
Влияние химической подготовки поверхности кремния на качество и структуру эпитаксиальных пленок карбида кремния, синтезированных методом замещения атомов	656
Яковлев С.А., Анкудинов А.В., Воробьев Ю.В., Воронов М.М., Козюхин С.А., Мелех Б.Т., Певцов А.Б.	
Лазерно-индуцированная модификация поверхности тонких пленок Ge₂Sb₂Te₅: фазовые изменения и формирование периодических структур	664
Капралова В.М., Сапурина И.Ю., Сударь Н.Т.	
Изменение проводимости полианилиновых нанотрубок в процессе их формирования	671